

Gemini 1

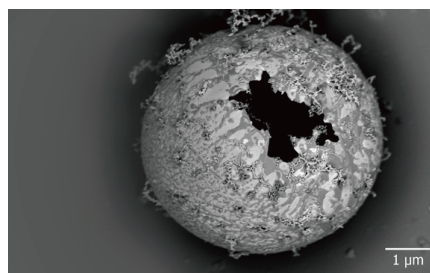
キャンペーン
2026年9月末
受注分まで

究極のイメージングと分析で未知の領域へ

多様な試料のサブナノメートルイメージングと
高度な分析を可能にするFE-SEM

ZEISS GeminiSEM Family

ZEISS GeminiSEM では、サブナノメートルの分解能でのイメージングを、様々な試料でストレス無く実現できます。ZEISS の最先端 FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）では、電子光学系のイノベーションと新しいチャンバー設計により、画質、操作性、柔軟性が向上しました。これにより、イマージョンレンズを使用せずに 1 kV 以下でサブナノメートル画像を取得できます。ZEISS GeminiSEM ファミリーの 3 種類の装置から、皆様の試料・アプリケーション・目的に応じた最適なソリューションをご提案します。



GeminiSEM 360 で取得したセリウム鉄粒子画像、
Inlens EsB 像

ZEISS GeminiSEM 360 対応できる試料の多様性は 最高クラス

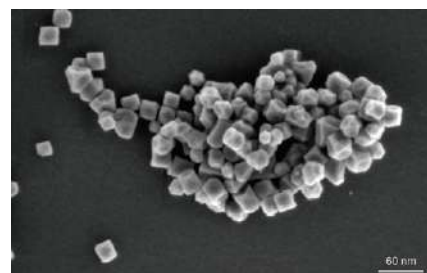
高感度表面イメージングにより、低加速電圧または高プローブ電流で情報を収集することができます。Inlens 検出、NanoVP など様々な条件でのイメージングに加え、コンテキストに基づいた画像統合管理やAIによるセグメンテーションのメリットを体感できます。



硬貨断面の EBSD 分析, GeminiSEM 460
20 kV, 5 nA, 20 分で 185,000 ポイント取得

ZEISS GeminiSEM 460 高分解能と高電流の両方に対応

低電流・低電圧の作業から、高電流・高電圧の作業にシームレスに切り替えることができます。また、加熱・引張実験用の in situ ソリューションを追加することも可能です。同一平面上のEDS/EBSD設定を活用することで、EDSデータの影のないマッピングや1秒あたり4,000パターンものEBSDマップの迅速な収集もできます。



磁性 FeMn ナノ粒子、辺長が約 25 nm の立方体
GeminiSEM 560, 1 kV, Inlens SE 像

ZEISS GeminiSEM 560 表面イメージングの新たな基準

試料バイアスやモノクロメーションを必要としない、1 kV 以下かつ 1 nm 以下の分解能での磁場フリーイメージング、新たな電子光学エンジン Smart Autopilot を搭載した Gemini 3、データ取得条件のスイートスポットを見つけるなど、表面イメージングの新たな基準となる様々な機能が搭載されています。

ZEISS GeminiSEM 360

GeminiSEM 360 ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡
インレンズ二次電子検出器、インレンズ EsB(反射電子)検出器、ET 検出器、
カラー CCD チャンバースコープ（仕様の詳細は弊社担当者にお問い合わせください。）

キャンペーン価格(税抜) **55,000,000 円～**

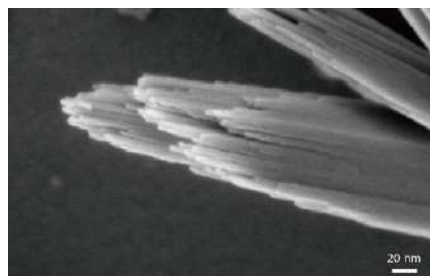


Seeing beyond

Gemini 1

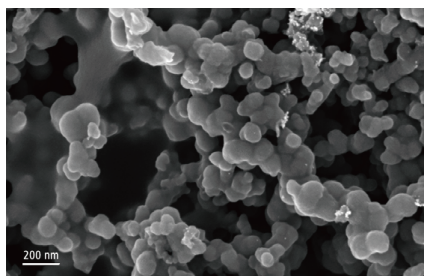
低加速電圧において高コントラストを実現！ さまざまなサンプルに対応可能 ZEISS GeminiSEM 360 / 460 / 560

ナノマテリアル



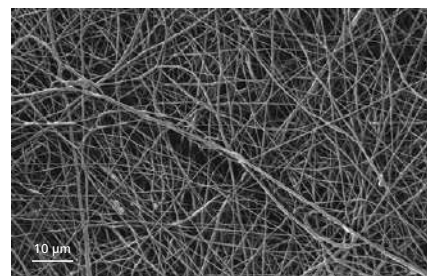
ナノメートル間隔で並んだ FeO(OH) 結晶。加速電圧：1 kV, 試料ご提供：L. Maniquet, INP Grenoble, France.

電池・エネルギー材料



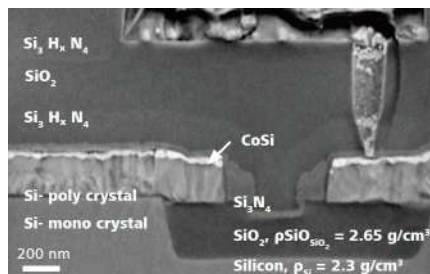
コーティングされていない電解質燃料電池材料。凝集したカーボンナノ粒子と直径 10 nm 未満のプラチナナノ粒子を含むマイクロボラス層

ポリマー・バイオ材料



組織工学でゼラチンナノファイバーを用いて作製した細胞培養用足場。試料ご提供：Fraunhofer IMWS, DE

エレクトロニクス



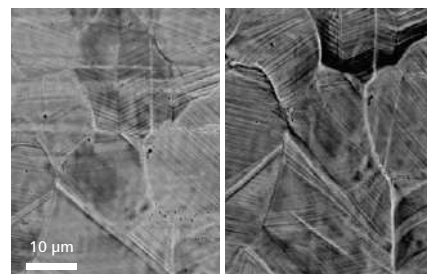
EsB 検出器(エネルギー選択 BSE 検出器)によって実現される材料コントラストは、電子デバイス材料の僅かな組成差を判別できます。

半導体素子解析



14 nm SRAM の EBAC(電子ビーム吸収電流法)解析。InLens 像(8 kV)と EBAC データ(赤)の重ね合わせ。

in situ 試験



ステンレス鋼の in situ(その場)引張試験中の AsB 像。引張によるスリップバンドの形成を、荷重前(左)および後(右)の画像で捉えています。

ZEISS GeminiSEM 360

分解能*	@ 30 kV (STEM)	0.6 nm
	@ 15 kV /DCV**	0.7 nm / 0.5 nm
	@ 1 kV /DCV**	1.2 nm / 1.0 nm
加速電圧		0.02 – 30 kV
倍 率		8x – 2,000,000x
プローブ電流		3 pA – 20 nA (100 nA: オプション)
VPモード		10 – 500 Pa (オプション)

* 最適動作距離：設置時の検収試験において、1 kV および 15 kV で分解能の実証を実施(高真空、DCV なし)

** デコンボリューション使用時の分解能



GeminiSEM ファミリーの
各製品や各種オプションの
詳細情報はこちら！



カールツァイス株式会社
ZEISS Research Microscopy Solutions
info.microscopy.jp@zeiss.com



Seeing beyond